面実装デバイス　アレイ型
Surface Mounting Device Diode Array

S1NAD80

800V 3A

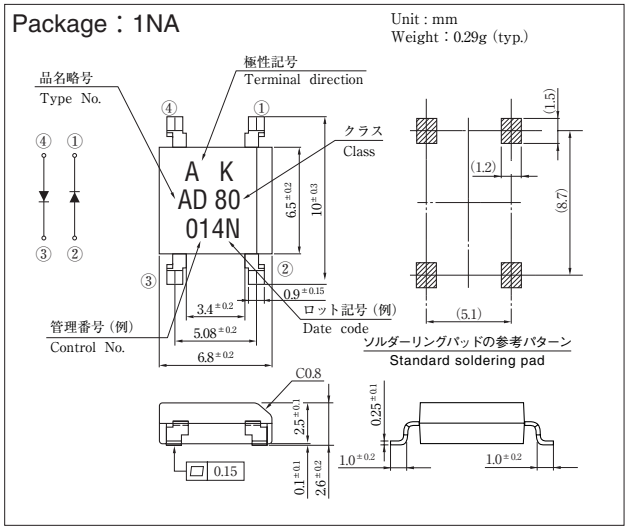
特長

- ●小型面実装
- ●ツイン
- ●耐湿性に優れ高信頼
- ●自動実装対応

Feature

- ●Small SMD
- ●Twin-Di
- ●High-Reliability
- ●for Auto-Mount

■外形寸法図　OUTLINE DIMENSIONS



（製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください）

■定格表　RATINGS

●絶対最大定格　Absolute Maximum Ratings（指定のない場合は T*l*＝25℃／unless otherwise specified）

項　目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions / 品名 Type No.		S1NAD80	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			−55～150	℃
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波，抵抗負荷，プリント基板実装，50Hz sine wave, Resistance load, On glass-epoxy substrate,	T*l*=102℃	3	A
			Ta=31℃	1.5	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波，非繰り返し1サイクルせん頭値，Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25℃		110	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I²t	1ms≦t＜10ms　Tj=25℃		60	A²s

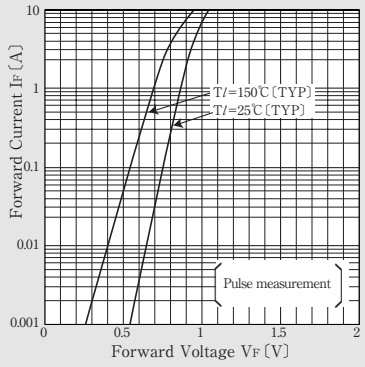
●電気的・熱的特性　Electrical Characteristics（指定のない場合は T*l*＝25℃／unless otherwise specified）

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=0.75A，パルス測定，一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 1.05	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=800V，パルス測定，一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode		MAX 10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θj*l*	接合部・リード間，プリント基板実装 Junction to Lead, On glass-epoxy substrate		MAX 15	℃/W
	θja	接合部・周囲間，プリント基板実装 Junction to Ambient, On glass-epoxy substrate	*1	MAX 84	

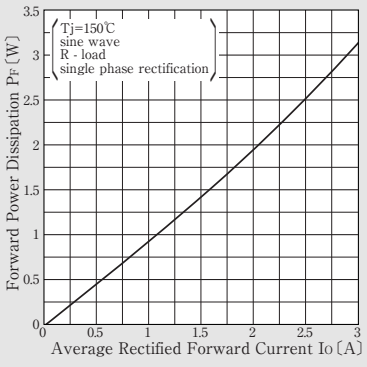
*1：銅箔パターン101㎟
Copper soldering pad Area 101㎟

■特性図　CHARACTERISTIC DIAGRAMS

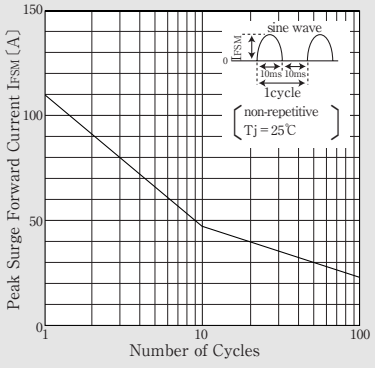
順方向特性
Forward Voltage



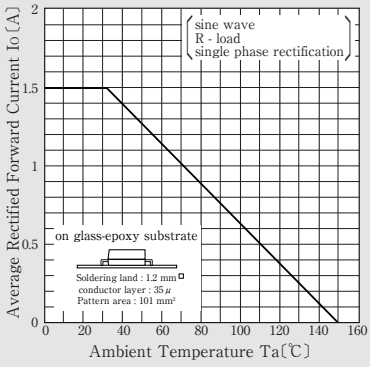
順電力損失曲線
Forward Power Dissipation



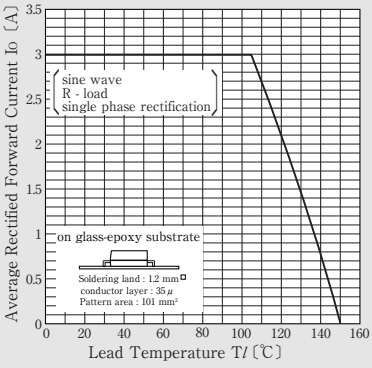
せん頭サージ電流耐量
Peak Surge Forward Current Capability



ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io



ディレーティングカーブ Tl-Io
Derating Curve Tl-Io



・Sine waveは50Hzで測定しています。
・50Hz sine wave is used for measurements.
・半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typicalは統計的な実力を表しています。
・Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.